

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第7部門第3区分
 【発行日】平成17年10月13日(2005.10.13)

【公開番号】特開2001-358567(P2001-358567A)

【公開日】平成13年12月26日(2001.12.26)

【出願番号】特願2000-178426(P2000-178426)

【国際特許分類第7版】

H 03K 17/06

H 03K 17/60

【F I】

H 03K 17/06 B

H 03K 17/60 Z

【手続補正書】

【提出日】平成17年6月10日(2005.6.10)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0015

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0015】

時点a1において、ハイサイド出力トランジスタT1のゲートにハイレベルの信号S13が入力されると、出力端子OUTが高電源電圧端子HVTの印加電圧近傍まで上昇する。この電圧上昇過程において、トランジスタM1、M2のそれぞれの寄生容量C1、C2に電流が流れ込んで充電される。これにより、抵抗R1、R2に発生する電圧を有する信号S11、S12は、図7において点線で示されたように変化する。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0043

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0043】

上述した実施の形態は一例であり、本発明を限定するものではない。例えば、上記第1の実施の形態では、ローサイド側の出力素子としてIGBT T2を用いている。しかし、この構成に限らず、図4に示された本発明の第2の実施の形態のように、トランジスタT2の替わりに抵抗R5を用いてもよい。この場合は、トランジスタT2のゲートに供給していた信号S6をエッジ検出回路1が生成する必要がないので、回路構成をより簡易にすることができる。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0045

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0045】

また、出力トランジスタT1、T2を上記第1の実施の形態ではIGBTで構成しているが、バイポーラトランジスタ、MOS型トランジスタ、あるいはサイリスタ等で構成してもよい。